TRANSLATION TO 11-097493 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-097493

(43) Date of publication of application: 09.04.1999

(51)Int.CI.

H01L 21/607 B06B 3/00 H01L 21/60

(21)Application number: 09-255008

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

19.09.1997

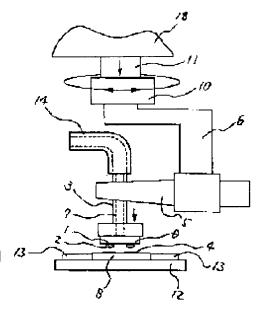
(72)Inventor: TOMIOKA TAIZO

(54) BONDING METHOD AND DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To widen an applicable range of bonding conditions, lessen a deformation amount of a bump, and bond at a narrow pitch by a method wherein a plurality of directions of ultrasonic vibrations are set and a deformation of a bump at a time of bonding is controlled.

SOLUTION: If positioning of a SAW device D absorbed to a bonding tool 3 and a ceramic substrate B fixed onto a work stage 12 is ended, a vertical drive mechanism 11 is activated, and an ultrasonic horn 5 is moved downward together with the bonding tool 3 to start a pressure to a bump 2, and the ultrasonic horn 5 is applied to the bonding tool 3. If applying is ended and the ultrasonic horn 5 is elevated up to a specified position, a support arm 6 is rotated at 90 degrees together with the ultrasonic horn 5 and the bonding tool 3, and the bonding tool 3 is dropped and brought into contact with a back surface of a SAW device



D to press and apply ultrasonic waves. Accordingly, the ultrasonic waves are applied in a different direction of the bump 2 to bond. It is possible to cope with a case where an electrode pad is fine-pitched.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		•

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

1 7/11

- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] this invention is the mounting technology of devices, such as a semiconductor, and it relates to the bonding method for performing flip chip bonding which carries out thermocompression bonding with a bonding tool, and bonding equipment, impressing an ultrasonic wave. [0002]

[Description of the Prior Art] The flip chip bonding which joins the electrode of a device and the electrode of a substrate through a bump has a small component-side product, has the feature that the wiring length of a circuit is short, and is suitable for high density assembly or mounting of a high-speed device. Especially, the thing using the golden ball bump with a comparatively easy formation process is put in practical use widely.

[0003] Explanation of the outline of those processes forms a golden bump by the ball bump method etc. on the electrode of devices, such as a SAW (Surface AcousticWave) device, beforehand. The device in which this golden bump was formed is adsorbed with the bonding tool which placed the bump forming face upside down and was attached in the ultrasonic horn in it. On the other hand, on the bonding stage currently heated by about 200 degrees C, the ceramic substrate to which gilding for electrodes was given is arranged. After alignment is performed by the camera etc., a bonding tool descends, and a device and a ceramic substrate pressurize a device to a ceramic substrate, and join. This pressurization is performed by usually being divided into two stages. That is, in the 1st phase, the barricade which remained in the bump is removed and it joins in the 2nd phase after that. Therefore, supersonic oscillation is first impressed for 800ms with an about [0.5W] low output, next supersonic oscillation is impressed for 800ms with the output of 2.0W. Under the present circumstances, since a bonding tool operates in the same state, the oscillating direction of an ultrasonic wave is the same direction.

[0004] If these equipments are explained based on drawing 6, the vertical drive 23 consists of an unilateral side of a pedestal 21, and a corresponding point of the support arm 22. This support arm 22 is supporting the ultrasonic horn 24 at the end.

[0005] The ultrasonic horn 24 holds the bonding tool 25 by the point. By the shape of a pipe, the adsorption hole 26 penetrates in the center section, the bonding tool 25 is formed in it, and the point forms the head 27 doubled with the configuration of an adsorption chip. The head 27 is adsorbed in the SAW device D in which the bump 28 was formed. Moreover, the other end of the bonding tool 25 was connected to the vacuum hose 29, and the other end of a vacuum hose 29 is connected to the pump which is not illustrated.

[0006] On the other hand, the bonding stage 30 arranges under the bonding tool 25. On the bonding stage 30, the ceramic substrate B by which the electrode 31 was formed in the front face is laid.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In order to secure a bonding strength by ultrasonic combined use by the flip chip bonding which carries out thermocompression bonding as compared with wirebonding etc., there is the need of impressing an ultrasonic wave to a bump with a high output at a long time. As well as reducing manufacture efficiency, when an ultrasonic wave is impressed from the same (b), as shown in drawing 7, a bump deforms this into an ellipse form for a long time in the direction of supersonic oscillation before and behind bonding. That is, since the major axis of the ellipse for which a bump deforms a bump's deformation permissible dose to electrode size is needed, the fitness range of bonding conditions receives restrictions in a degree very much. For this reason, correspondence when an electrode pad forms a detailed pitch is difficult.

[0008] It was made under such a situation, and a bump's deformation is lessened, and this invention is good and offers the method and equipment which can perform bonding of a ** pitch while it secures the proper range of bonding conditions in the latus range by controlling deformation of the bump at the time of bonding.

[0009]

[Means for Solving the Problem] According to this invention, it is in the bonding method which becomes considering the direction of the aforementioned supersonic oscillation as plurality in the bonding method which impresses supersonic oscillation for the aforementioned electrode through the aforementioned bump, and carries out thermocompression bording of the device which has the substrate in which the electrode was formed and installed the bump in the aforementioned electrode, and the envelope in which the electrode was formed mutually.

[0010] Moreover, according to this invention, it is the bonding method characterized by for impression of the ultrasonic wave to a bonding tool performing the aforementioned bonding, and performing it whenever a bonding tool rotates a

predetermined angle by the rotation means.

[0011] Moreover, according to this invention, it is in the bonding method characterized by performing the aforementioned work stage whenever impression of the ultrasonic wave to the aforementioned bonding tool rotates a

predetermined angle.

[0012] Moreover, according to this invention, it has the bonding tool with which the seal of approval of the supersonic oscillation countered and prepared in a work stage and this is carried out. In the bonding equipment which impresses and carries out thermocompression bonding of the ultrasonic wave to the electrode of the envelope laid on the work stage in the bump formed in the electrode of the device by which the aforementioned bonding tool was adsorbed at a bonding tool The bonding equipment characterized by having an oscillating direction change means to change the oscillating direction has impression of the ultrasonic wave to the aforementioned bonding tool.

[Embodiments of the Invention] The operation gestalt of this invention is explained with reference to a drawing below. [0014] <u>Drawing 1</u> is the block diagram showing the ** type of the 1st operation gestalt of this invention, and explains the case where it applies to the SAW device D like a Prior art. As for the dimension of the SAW device D, the electrode 1 is formed in the front face by 2.0x2.0x0.4 (mm). 16 pieces are formed of sputtering with aluminum, and an electrode 1 is [the thickness of the size of each electrode 1] 0.7 micrometers in **120micrometer. The golden ball bump 2 with a diameter [of 70 micrometers] and a height of 30 micrometers is formed in the electrode 1 at each. Moreover, as an envelope which mounts this device, the electrode 4 of a tungsten / nickel / gold was constituted on the ceramic substrate B of an outer diameter 3.0x3.0x0.5 (mm). In addition, it formed in the electrode front face by 0.4-micrometer gilding by the electroless-plating method.

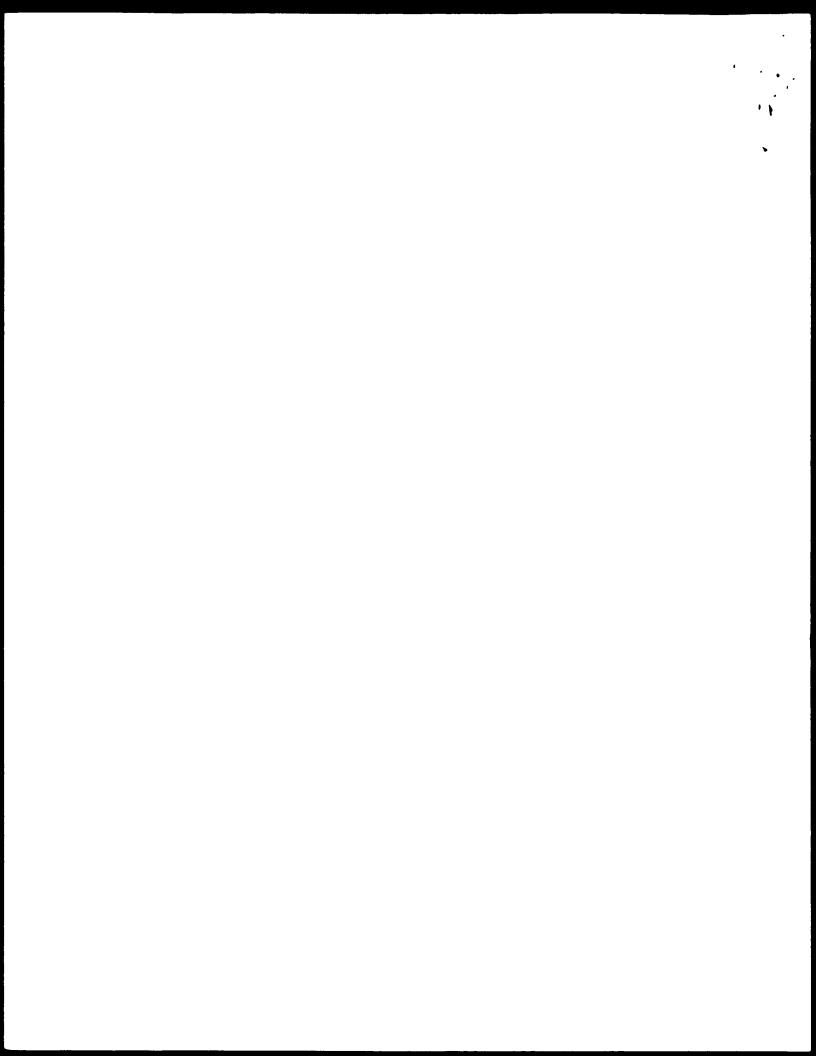
[0015] If the equipment which carries out flip chip bonding of these devices is explained, the ultrasonic horn 5 is supported with the support arm 6, and is carrying out fixed maintenance of the bonding tool 3 at the point. The through hole 7 for adsorbing a device is formed in the bonding tool 3. The elastic vacuum hose 14 connected with the other end of a bonding tool, and the vacuum hose 14 is connected to the pump which is not illustrated. The other end of the ultrasonic horn 5 is connected to the source of an ultrasonic wave which is not illustrated. The other end of the support arm 6 is connected to theta shaft rotation motor 10, and the main part 18 of bonding equipment is equipped with this theta shaft rotation motor 10 through the vertical drive 11.

[0016] On the other hand, the work stage 12 is arranged under the bonding tool 3, and the plate 13 which fixes the ceramic substrate B is formed on the work stage 12.

[0017] After performing alignment of the ceramic substrate B currently fixed on the SAW device D by which the bonding tool 3 was adsorbed with the camera which is not illustrated when the operation by such structures was explained, and the work stage 12 and completing alignment within the limits of predetermined, the vertical drive 11 operates and the ultrasonic horn 5 moves below. Therefore, the bonding tool 3 moves below similarly and the pressurization to the bump 2 of a device is started. If a pressurization load reaches 1Kgf, the source of supersonic oscillation will operate and the ultrasonic horn 5 will be impressed to the bonding tool 3 for 200ms by output 1.5W. After this impression is completed, adsorption of a device is canceled, the vertical drive 11 operates, and the bonding tool 3 goes up to a predetermined position. Since theta shaft rotation motor 10 will operate and the support arm 6 will rotate 90 degrees if the bonding tool 3 goes up to a predetermined position, the ultrasonic horn 5 and the bonding tool 3 also rotate 90 degrees. The vertical drive 11 operates again in this state, drop the bonding tool 3, and it is made to contact to the rear face of the SAW device D, and pressurizes. If a pressurization load reaches 1Kgf, supersonic oscillation will be impressed for 200ms by output 2.0W, after impression is completed, the vertical drive 11 operates, the bonding tool 3 goes up and bonding ends it. Therefore, bonding was able to be performed towards the directions of the ultrasonic wave/impressed to a bump 2 as shown in drawing 2 (a, b) differing.

[0018] After bonding junction, while measuring sticking-by-pressure bump 2 path, as shown in <u>drawing 3</u>, ** was measured for bond strength (shear strength) using the share tool 14. The bump 2 was deforming maintaining an approximate circle form, a bump's 2 diameter of sticking by pressure is 100 micrometers, the correspondence to the pad of **120-micrometer size is possible enough, and, as for the shear strength, 100gf(s) and sufficient intensity were obtained per bump.

[0019] In addition, since there is the need of impressing ultrasonic output 2.0W for 500ms in order to obtain an



equivalent bonding strength by the conventional method (the oscillating direction of the ultrasonic wave impressed is ** on the other hand), the bump 2 deformed into the ellipse form and the major axis amounted to 120 micrometers, the application to the pad of **120-micrometer size was difficult.

[0020] As for the parts in which drawing 4 shows the gestalt of other operations to and the same previous parts as a gestalt or the same previous function of operation is shown, the same sign is attached. It is being fixed to the main part of equipment by the support arm 6, and the ultrasonic horn 5 is carrying out fixed maintenance of the bonding tool 3 at the point. Moreover, the elastic vacuum hose 14 connected with the other end of the bonding tool 3, and the vacuum hose 14 is connected to the pump which is not illustrated. The other end of the ultrasonic horn 5 is connected to the source of an ultrasonic wave which is not illustrated.

[0021] On the other hand, the work stage 12 is arranged under the bonding tool 3, and the plate 13 which fixes a substrate is formed on the work stage 12. The rolling mechanism 15 which made the motor the source of power is

connected to the lower part of this work stage 12.

[0022] Since the vertical drive 11 operates and the ultrasonic horn 5 moves below after performing alignment of the ceramic substrate B currently fixed on the SAW device D by which the bonding tool 3 was adsorbed with the camera which is not illustrated when the operation by such structures was explained, and the work stage 12 and completing alignment within the limits of predetermined, the bonding tool 3 moves below similarly and the pressurization to the bump 2 of a device is started. A pressurization load is 1Kgf. If it reaches, the source of supersonic oscillation will operate, and the ultrasonic horn 5 is output 1.5W to the bonding tool 3. It impresses for 200ms. After this impression is completed, adsorption of a device is canceled, the vertical drive 11 operates, and the bonding tool 3 goes up to a predetermined position. If the bonding tool 3 goes up to a predetermined position, a motor rotates, a rolling mechanism 15 will operate and the work stage 12 will be rotated 90 degrees. The vertical drive 11 operates again in this state, drop the bonding tool 3, and it is made to contact to the rear face of the SAW device D, and pressurizes. If a pressurization load reaches 1Kgf, supersonic oscillation will be impressed for 200ms by output 2.0W, after impression is completed, the vertical drive 11 operates, the bonding tool 3 goes up and bonding ends it.

[0023] <u>Drawing 5</u> is the plan showing the gestalt of still more nearly another operation, fixed support of the 1st bonding tool 3a is carried out at 1st ultrasonic horn 5a, and 2nd bonding tool 3b is supported by 2nd ultrasonic horn 5b. 1st ultrasonic horn 5a and 2nd ultrasonic horn 5b are being fixed to the main part 18 of equipment through the support arms 6a and 6b and the vertical drives 11a and 11b, respectively, after the angle has displaced 90 degrees. Other composition

is the same as that of the gestalt of above-mentioned operation.

[0024] On the other hand, the work stage 12 which carries out installation fixation of the substrate 2 under the bonding tools 3a and 3b is formed. This work stage 12 is set up with X-Y table structure possible [movement into the operating

range of each bonding tools 3a and 3b].

[0025] If the operation by such structures is explained, alignment of the ceramic substrate B currently fixed on the SAW device D by which 1st bonding tool 3a was adsorbed with the camera which is not illustrated, and the work stage 12 will be performed. Since the vertical drive of 1st ultrasonic wave horn 5a operates and ultrasonic horn 5a moves below after alignment is completed within the limits of predetermined, 1st bonding tool 3a moves below similarly, and starts the pressurization to the bump 2 of a device. If a pressurization load reaches 1Kgf, the source of supersonic oscillation will operate and 1st ultrasonic horn 5a will be impressed to 1st bonding tool 3a for 200ms by output 1.5W. After this impression is completed, adsorption of a device is canceled, a vertical drive operates and 1st bonding tool 3a goes up to a predetermined position. If 1st bonding tool 3a goes up to a predetermined position, the work stage 12 will operate and will be moved to the predetermined position of the lower part of 2nd bonding tool 3b. The vertical drive of 2nd ultrasonic horn 5b operates in this state, drop 2nd bonding tool 3b, and it is made to contact to the rear face of the SAW device D, and pressurizes. If a pressurization load reaches 1Kgf, supersonic oscillation will be impressed for 200ms by output 2.0W, after impression is completed, a vertical drive operates, bonding tool 3b goes up and bonding ends it. [0026] In addition, this invention is not limited to the gestalt of the above-mentioned implementation, and although it showed application to the SAW device D as electronic parts with the gestalt of operation mentioned above, it is applicable to a semiconductor device similarly. You may use a plating bump also about a bump. In addition, it cannot be overemphasized that deformation implementation is variously possible in the range which does not deviate from the meaning of this invention.

[0027]

[Effect of the Invention] Since the oscillating direction is changed and it was made to perform impression of the ultrasonic wave to a bonding tool in this invention two or more times in the bonding of ultrasonic combined use as stated above, bonding which does not deform the Banff configuration into elliptical etc. could be performed. Consequently, while being able to take the large fitness range of bonding conditions, even when a detailed pitch was formed by the electrode pad, it could respond.

		•	

*NOTICES *

Capan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2. **** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The bonding method which becomes considering the direction of the aforementioned supersonic oscillation as plurality in the bonding method which impresses supersonic oscillation for the aforementioned electrode through the aforementioned bump, and carries out thermocompression bonding of the device which has the substrate in which the electrode was formed and installed the bump in the aforementioned electrode, and the envelope in which the electrode was formed mutually.

[Claim 2] The aforementioned bonding is the bonding method according to claim 1 characterized by performing impression of the ultrasonic wave to a tool using a bonding tool whenever the aforementioned bonding tool rotates a predetermined angle by the rotation means.

[Claim 3] The aforementioned bonding is the bonding method according to claim 1 characterized by performing the aforementioned work stage using a bonding tool whenever impression of the ultrasonic wave to a tool rotates a predetermined angle.

[Claim 4] The aforementioned bonding is the bonding method according to claim 1 characterized by performing impression of the ultrasonic wave to a tool using a bonding tool by two or more bonding heads from which the oscillating direction of an ultrasonic wave differs.

[Claim 5] It has the bonding tool with which the supersonic oscillation countered and prepared in a work stage and this is impressed. In the bonding equipment which impresses and carries out thermocompression bonding of the ultrasonic wave to the electrode of the envelope laid on the work stage in the bump formed in the electrode of the device by which the aforementioned bonding tool was adsorbed at a bonding tool Impression of the ultrasonic wave to the aforementioned bonding tool is bonding equipment characterized by having an oscillating direction change means to change the oscillating direction.

[Translation done.]

		, ,
	· •	



類似技術

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-97493

(43)公開日 平成11年(1999)4月9日

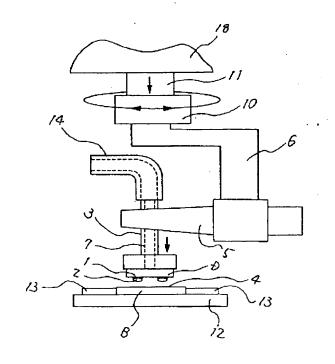
91 /	識別記号	FI
	21/607	H 0 1 L 21/607 B
21/	17 001	C
37	3/00	В 0 6 В 3/00
	21/60 3 1 1	H01L 21/60 311S
		審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)
一—	特顧平9-255008	(71)出題人 000003078
		株式会社東芝
	平成9年(1997)9月19日	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72)発明者 富岡 泰造
		神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株
		式会社東芝生産技術研究所内
		(74)代理人 弁理士 大胡 典夫 (外1名)
		-
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

(54) 【発明の名称】 ボンディング方法および装置

(57)【要約】

【課題】 半導体等の電子部品の実装技術で、超音波を 印加しながらボンディングツールで熱圧着するフリップ チップボンディングを行うためのボンディング方法とボ ンディング装置で、バンプが円形形状を維持して接合さ せる方法と装置を提供すること。

【解決手段】 デバイスの電極1に形成されたバンプ2をワークステージ12上に載置された外囲器の電極4にボンディングツール3に超音波を印加して熱圧着するボンディング方法で、ボンディングツール3への超音波の印加は振動方向を変化させて複数回行う。



【特許記 "の範囲】

【請求項』】 電極を形成した基板を有し前記電極にバンプを設置したデバイスと電極を形成した外囲器とを前記電極を前記パンプを介して超音波振動を印加して相互に熱圧着するポンディング方法において、前記超音波振動の方向を複数としてなるポンディング方法。

【請求項2】 前記ポンディングはポンディングツールを使用しツールへの超音波の印加は、回転手段によって前記ポンディングツールが所定角度を回動させる毎に行うことを特徴とする請求項1記載のポンディングツールを使用しツールへの超音波の印加は、前記ワークステージを所定角度を回動させる毎に行うことを特徴とする請求項1記載のポンディング方法。

【請求項4】 前記ポンディングはポンディングツール を使用しツールへの超音波の印加は、超音波の振動方向 の異なる複数のポンディングヘッドによって行うことを 特徴とする請求項1記載のポンディング方法。

【請求項 5 】 ワークステージとこれに対向して設けられた超音波振動が印加されるポンディングツールとを有 20 る。し、前記ポンディングツールに吸着されたデバイスの電極に形成されたパンプをワークステージ上に載置された外囲器の電極にポンディングツールに超音波を印加して タス 熱圧着するポンディング装置において、前記ポンディングツールへの超音波の印加は振動方向を変化させる振動方向変更手段を有することを特徴とするポンディング装置。 27

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体等のデバイスの実装技術で、超音波を印加しながらポンディングツールで熱圧着するフリップチップポンディングを行うためのポンディング方法とポンディング装置に関する。

[0002]

【社主の技術】デバイスの電極と基板の電極とをバンプを介して接合するフリップチップボンディングは、実装面積が小さく、回路の配線長さが短いという特長が有り、高密度実装や高速デバイスの実装に適している。特に、形成プロセスが比較的容易である金ボールバンプを用いたものが広く実用化されている。

【0003】それらのプロセスの概要について説明すると、予めSAW(Surface AcousticWave)デバイス等のデバイスの電極上にボールパンプ方式等で金パンプを形成する。この金パンプの形成されたデバイスをパンプ形成面を下向きにして超音波ホーンに取付けられたボンディン「ツールで吸着する。一方、200℃程度に加熱されているボンディングステージ上には電極用金めっきが施されたセラミックをはカメラ等により位置合わせが行われた後に、ボニティングツールが下降してデバイスをセラミッ

ク基板へ加圧し接合する。この加圧は通常2段階に分けられて行われる。つまり、第1段階ではパンプに残ったパリを除去し、その後、第2段階で接合する。従って最初に0.5W程度の低い出力で超音波振動を800ms印加し、次に、2.0Wの出力で超音波振動を800m

s印加する。この際、ポンディングツールは同一状態で 作動するので超音波の振動方向は同一方向である。

すると、基台21の一側面と支持アーム22の対応部と 10 で上下駆動機構23が構成されている。この支持アーム 22は一端に超音波ホーン24を支持している。

【0004】これらの装置について図6に基づいて説明

【0005】超音波ホーン24は先端部でボンディングツール25を保持している。ボンディングツール25はパイプ状で中央部に吸着穴26が貫通して設けられ先端部は吸着チップの形状に合わせたヘッド27を形成している。ヘッド27にはパンプ28が形成されたSAWデバイスDが吸着されている。また、ボンディングツール25の他端はパキュームホース29に接続され、パキュームホース29の他端は図示しないポンプへ接続している。

【0006】一方、ボンディングツール25の下方にはボンディングステージ30が配置している。ボンディングステージ30上には表面に電極31が形成されたセラミック基板Bが載置されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】超音波併用で熱圧着するフリップチップボンディングではワイヤボンディング等と比較して接合強度を確保するために、超音波を高い出力で長時間に亘ってパンプに印加する必要が有る。これは、製造効率を低下させるのは勿論、超音波が同一方向(b)から印加された場合は、図7に示すようにパンプがボンディングの前後で超音波振動の方向へ長く楕円形に変形する。つまり、電極サイズに対するパンプの変形許容量がパンプが変形する楕円の長径が必要になるため、電極パッドが微細ピッチ化した場合の対応が困難である。

【0008】本発明はこのような事情でなされたもので、ボンディング時のパンプの変形を制御することにより、ボンディング条件の適正範囲を広い範囲で確保すると共に、パンプの変形量を少なくして良好で狭ピッチのボンディングを行える方法と装置を提供するものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、電極を 形成した基板を有し前記電極にパンプを設置したデバイ スと電極を形成した外囲器とを前記電極を前記パンプを 介して超音波振動を印加して相互に熱圧着するポンディ ング方法において、前記超音波振動の方向を複数として 50 なるポンディング方法にある。

2

【0010】また、本発明によれば、前記ボンディングはボンディングツールへの超音波の印加によって行い、回転手段によってボンディングツールが所定角度を回動させる毎に行うことを特徴とするボンディング方法である。

【0011】また、本発明によれば、前記ボンディングツールへの超音波の印加は、前記ワークステージを所定角度を回動させる毎に行うことを特徴とするボンディング方法にある。

【0012】また、本発明によれば、ワークステージとこれに対向して設けられた超音波振動が印可されるボンディングツールとを有し、前記ボンディングツールに吸着されたデバイスの電極に形成されたバンブをワークステージ上に載置された外囲器の電極にボンディングツールに超音波を印加して熱圧着するボンディング装置において、前記ボンディングツールへの超音波の印加は振動方向を変化させる振動方向変更手段を有することを特徴とするボンディング装置にある。

[0013]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施形態について図 面を参照して説明する。

【0014】図1は本発明の第1の実施形態の模式を示す構成図で、従来の技術と同様にSAWデバイスDに適用した場合を説明する。SAWデバイスDの外形寸法は $2.0\times2.0\times0.4$ (mm)で表面に電極1が設けられている。電極1はアルミニウムで16個がスパッタリングにより形成され、各電極1のサイズはD120 μ mで厚さは 0.7μ mである。電極1にはそれぞれには直径 70μ m、高さ 30μ mの金ボールバンプ2が形成されている。また、このデバイスを実装する外囲器としては外径 $3.0\times3.0\times0.5$ (mm)のセラミック基板B上にタングステン/ニッケル/金の電極4を構成した。なお、電極表面には無電解めっき法で 0.4μ mの金めっきで形成した。

【0015】これらのデバイスをフリップチップボンディングする装置を説明すると、超音波ホーン 5 は支持アーム 6 で支持され先端部にボンディングツール 3 を固定保持している。ボンディングツール 3 にはデバイスを吸着するための貫通穴 7 が設けられている。ボンディングツールの他端部には伸縮自在なバキュームホース 1 4 が接続しバキュームホース 1 4 は図示しないポンプへ接続している。超音波ホーン 5 の他端部は図示しない超音波原に接続している。支持アーム 6 の他端は Θ 軸回転モータ 1 0 に接続されこの Θ 軸回転モータ 1 0 は上下駆動機構 1 1 を介してボンディング装置本体 1 8 に装着されている。

【0016】一方、ポンディングツール3の下方にはワークステージ12が配設されワークステージ12上にはセラミック基板Bを固定するプレート13が設けられている。

【0017】これらの構造による作用を説明すると、図 示しないカメラでポンディングツール3に吸着されたS AWデバイスDとワークステージ12上に固定されてい るセラミック基板Bの位置合わせを行い、所定の範囲内 に位置合わせが終了すると上下駆動機構11が作動して 超音波ホーン5は下方へ移動する。従って、ポンディン グツール3も同様に下方へ移動しデバイスのバンプ2へ の加圧を開始する。加圧荷重が1 Kgfに達すると超音 波振動源が作動して超音波ホーン5はポンディングツー ル3に出力1.5Wで200ms印加する。この印加が 終了するとボンディングツール3はデバイスの吸着を解 除し、上下駆動機構11が作動して所定位置まで上昇す る。ボンディングツール3が所定位置まで上昇するとΘ 軸回転モータ10が作動して支持アーム6が90度回転 するので、超音波ホーン5とボンディングツール3も9 0度回転する。この状態で再び上下駆動機構11が作動 してボンディングツール3を下降させSAWデバイスD の裏面へ接触させ加圧する。加圧荷重が1 K g f に達す ると超音波振動を出力2.0Wで200ms印加し、印

図2に示すようにバンブ2に印加される超音波の方向 (a、b)が異なる方向でポンディングを行うことが出来た。

グツール3は上昇しポンディングが終了する。従って、

20 加が終了すると上下駆動機構11が作動してポンディン

【0018】ボンディング接合後に、圧着バンプ2径を 測定すると共に図3に示すようにボンディング強度(せん断強度)をシェアツール14を用いてを測定した。バンプ2は略円形を保ちながら変形しておりバンプ2の圧 着径は 100μ mで、 $\Box 120\mu$ mサイズのパッドへの が応は十分可能であり、せん断強度はバンプ当たり1000 gfと十分な強度が得られた。

【0019】なお、従来方式(印加される超音波の振動方向が一方向)では同等の接合強度を得るためには、超音波出力 2.0Wを500ms印加する必要が有り、パンプ 2 は楕円形に変形してその長径は 120μ mに達したため 120μ mサイズのパッドへの適用は困難であった。

【0020】図4は他の実施の形態を示すもので、先の実施の形態と同一部品又は同一機能を示す部品は同一符40 号が付されている。超音波ホーン5は支持アーム6によって装置の本体に固定されており、先端部にポンディングツール3の他端部には伸縮自在なパキュームホース14が接続しパキュームホース14は図示しないポンプへ接続している。超音波ホーン5の他端部は図示しない超音波原に接続している。

【0021】一方、ボンディングツール3の下方にはワークステージ12が配設されワークステージ12上には 基板を固定するプレート13が設けられている。このワ 50 ークステージ12の下部にはモータを動力源とした回転 機構15が接続されている。

【0022】これらの構造による作用を説明すると、図 示しないカメラでボンディングツール3に吸着されたS AWデバイスDとワークステージ12上に固定されてい るセラミック基板Bの位置合わせを行い、所定の範囲内 に位置合わせが終了すると上下駆動機構11が作動して 超音波ホーン5は下方へ移動するので、ポンディングツ ール3も同様に下方へ移動しデバイスのバンプ2への加 圧を開始する。加圧荷重が1kgf に達すると超音波振動 源が作動して超音波ホーン5はポンディングツール3に 出力1.5Wで200ms印加する。この印加が終了する とポンディングツール3はデバイスの吸着を解除して上 下駆動機構11が作動して所定位置まで上昇する。 ポン ディングツール3が所定位置まで上昇するとモータが回 転して回転機構15が作動しワークステージ12は90 度回転する。この状態で再び上下駆動機構11が作動し てポンディングツール3を下降させSAWデバイスDの 裏面へ接触させ加圧する。加圧荷重が1Kgfに達する と超音波振動を出力2.0Wで200ms印加し、印加 が終了すると上下駆動機構11が作動してポンディング 20 ツール3は上昇しポンディングが終了する。

【0023】図5は更に別の実施の形態を示す平面図 で、第1のポンディングツール3aは第1の超音波ホー ン5aに固定支持され、第2のポンディングツール3b は第2の超音波ホーン5 bに支持されている。第1の超 音波ホーン5aと第2の超音波ホーン5bとは90度角 度が変位した状態でそれぞれ支持アーム6a、6bと上 下駆動機構11a、11bを介して装置本体18に固定 されている。その他の構成は上述の実施の形態と同様で ある。

【0024】一方、ポンディングツール3a,3bの下 方には基板2を載置固定するワークステージ12が設け られている。このワークステージ12はXYテーブル構造 で各ポンディングツール3a,3bの動作範囲内に移動 可能に設定されている。

【0025】これらの構造による作用を説明すると、図 示しないカメラで第1のポンディングツール3 a に吸着 されたSAWデバイスDとワークステージ12上に固定 されているセラミック基板Bの位置合わせを行い、所定 の範囲内に位置合わせが終了すると第1超音波ホーン5 aの上下駆動機構が作動して超音波ホーン5aは下方へ 移動するので、第1のポンディングツール3aも同様に 下方へ移動しデバイスのバンプ2への加圧を開始する。 加圧荷重が1Kgfに達すると超音波振動源が作動して 第1の超音波ホーン5aは第1のポンディングツール3 aに出力1.5Wで200ms印加する。この印加が終 了すると第1のポンディングツール3 a はデバイスの吸 着を解除して上下駆動機構が作動して所定位置まで上昇

する。第1のポンディングツール3aが所定位置まで上 昇するとワークステージ12は作動して第2のポンディ ングツール3bの下方の所定位置に移動する。この状態 で第2の超音波ホーン5bの上下駆動機構が作動して第 2のポンディングツール3bを下降させSAWデバイス Dの裏面へ接触させ加圧する。加圧荷重が1Kgfに達 すると超音波振動を出力2.0Wで200ms印加し、 印加が終了すると上下駆動機構が作動してポンディング

【0026】なお、本発明は上記実施の形態に限定され るものではなく、例えば、上述した実施の形態では電子 部品としてSAWデバイスDへの適用を示したが、半導 体デバイスへも同様に適用することが出来る。パンプに ついてもめっきパンプを用いてもよい。その他にも本発 明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能であるの は言うまでもない。

[0027]

【発明の効果】以上に述べたように本発明では、超音波 併用のポンディングにおいてポンディングツールへの超 音波の印加を振動方向を変化させて複数回行うようにし たので、バンフ形状が楕円形状等に変形しないポンディ ングを行うことが出来るようになった。その結果、ポン ディング条件の適性範囲を広く取ることが出来ると共 に、電極パッドが微細ピッチ化した場合でも対応できる ようになった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の模式を示す構成図。

【図2】本発明における超音波振動の方向を示す説明

30 【図3】形成されたバンプのせん断強度測定の説明図。

【図4】本発明の別の実施の形態を示す構成図。

【図5】本発明の更に別の実施の形態を示す構成図。

【閏6】従来の実施の形態を示す構成図。

【図7】従来の実施の形態でのパンプの形状を示す説明 ☒.

【符号の説明】

1…電極 (デバイス)

2…バンプ

3…ポンディングツール

4…電極 (基板)

5…超音波ホーン

7…キャピラリー

8…ヘッド

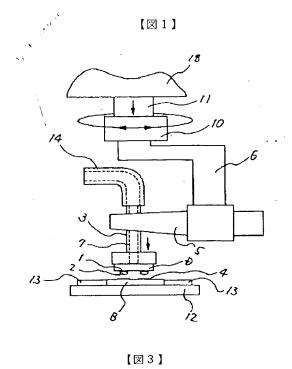
10…Θ軸回転モータ

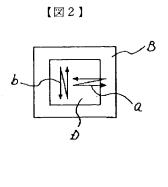
11…上下駆動機構

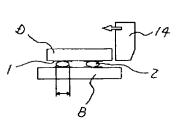
12…ワークステージ

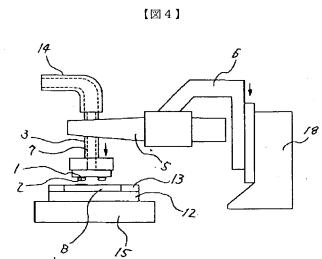
15…回転機構

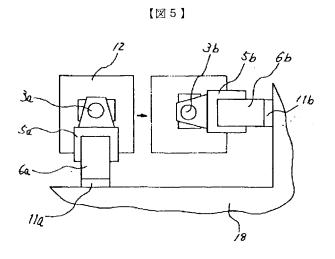
ツール3 bは上昇しポンディングが終了する。

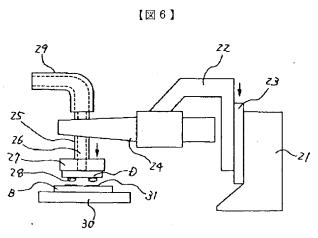












[図7]

